

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CBO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直 流 又 は バ ル ス hFE		バ イ ア ス		h _{je} f _T *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻¹)	h _{oc} h _{ob} * (μU)	f _{ob} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(Real)} * (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC710	三 菱	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	4	30	200	125	1	25	90	6	1	6	-1				200*	2	C _c r _{bb'} 20pS	138B		
" 711	"	RF.AF	"	30	4	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1		8500	0.6	40	150*	2.5	C _c r _{bb'} 200pS	138B	
" 712	"	AF	"	30	4	100	200	125	1	25	90	6	10	6	-1		2500	0.4	15	150*	2.5	C _c r _{bb'} 150pS	138B	
★ " 712A	"	"	"	30	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	180*	2.5	C _c r _{bb'} 150pS	138B	
★ " 713	"	SW	"	30	4	100	200	125	0.1	25	90	6	10				t _{on} < 60nS, t _{off} < 150nS t _{sig} < 120nS		150*	2.5		138B		
★ " 714	"	"	"	70	5	200	250	125	0.1	25	60	6	10	6	-10		t _{on} < 40nS, t _{off} < 250nS t _{sig} < 150nS		200*	7		138B		
★ " 715	三 洋	RF.V	"	40	5	100	120	125	1	35	180	6	1	6	-1		3500	0.8		140*	4	C _c r _{bb'} 250pS	27	
★ " 716	"	"	"	20	5	100	100	125	1	15	180	6	1	6	-1		3500	0.8	13	140*	4	C _c r _{bb'} 250pS	27	
★ " 717	日 立	RF.Conv.Mix Osc	"	30	2	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	6	-1	40	PG = 18dB (f = 200Mc)		1100*	1.2	C _c r _{bb'} 10pS	37		
" 718	富士通	SW	"	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	-10	t _r = 4 nS, t _f = 9 nS t _s = 6 nS			800*	2		49C		
" 719	"	"	"	20	4	200	200	175	0.4	15	60	1	10	10	-10	t _r = 4 nS, t _f = 9 nS t _s = 6 nS			800*	2		46C		
★ " 720	"	RF	Si.P	25	3	20	200	175	0.05	6				6	-2	100	PG = 30dB (f = 45Mc)		500*	1.2	80*	50C	フォワード AGC	
★ " 721	"	"	"	25	3	20	200	120	0.05	6				6	-2	100	PG = 30dB (f = 45Mc)		500*	1.4	80*	30	フォワード AGC	
★ " 722	"	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	20		25	200	125	0.5	12				6	-2	80			700*	1.5	80*	30		
★ " 723	"	"	Si.P	20		25	200	125	1	12				6	-2	60			500*	1.5	80*	30		
" 724	"	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70	t _r < 20nS, t _f < 50nS t _s < 250nS		250*	4	80*	138		
" 725	"	"	"	60	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70	t _r < 20nS, t _f < 50nS t _s < 250nS		250*	4	80*	138		
★ " 726	"	SW	"	20	4	200	200	125	1	15	60	1	10		-2		t _r = 4 nS, t _f = 9 nS t _s = 6 nS					30		
" 727	"	RF.AF.SW	Si.T	100	3	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60	1200	1	12	20*	9	40	49C	
" 728	"	"	"	200	6	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60	1200	1	12	20*	10	40*	49C	
★ " 729	日 電	RF	Si.E	50	5	200	600	175	0.5	30				10	-10	60			250*	4	40	84B		
" 730	三 菱	PA	Si.EP	40	4	400	1.03W	175	10	15	50	10	100				P _o = 1.5W (f = 150Mc, V _{CC} = 13.5V, P _i = 0.1W)					84B		
" 731	松 下	"	"	40	4	500	2.5W (T _c = 25°C)	175	1	20	70	13.5	100				P _o = 1.2W (f = 500MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 0.3W)					84B		
★ " 732	東 芝	LN	Si.E	60	5	150	400	125	0.1	60	200~ 700	6	2	6	-1				150*	2		138		
" 733	"	RF	"	35	5	100	300	125	0.1	18	70~700	6	2	6	-1				>80*	7	C _c r _{bb'} 150pS	33		
★ " 734	"	"	"	70	5	150	300	125	0.1	18	70~400	1	20	6	-10				150*	5	15	33	2SA561 とコンプリ	
★ " 735	"	"	"	35	5	400	300	125	0.1	18	70~400	1	100	5	-50				300*	7	C _c r _{bb'} 150pS	33	2SA562 とコンプリ	
★ " 736	日 電	SW	"	135	5	5 A	50 W (T _c = 25°C)	175	500	60	60	10	1 A				t _{on} < 2 μS, t _{off} < 4 μS t _{sig} = 3 μS					102		
" 737	三 菱	PA	Si.EP	60	5	1.5A	17 W (T _c = 25°C)	175	500	30	50	10	100				P _o = 14W (f = 150MHz, V _{CC} = 25V, P _m = 1.9W)					113		
" 738	"	RF Conv. Osc	"	25	4	20	150	125	1	12	55~180	6	1	6	-1				440*	1.5	C _c r _{bb'} 30pS	138B		